

삼성전자, 30나노급 D램 개발

2012년 1.25V 서버용으로 공급 ... 전력 소비 15% 절감

삼성전자는 4Gb DDR3(Double Data Rate 3) D램을 기반으로 엔터프라이즈 서버용 1.25V 16GB(기가바이트) DDR3 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module)을 개발했다고 9월15일 발표했다.

삼성전자는 9월16일 싱가포르에서 열리는 삼성 반도체 최고정보관리책임자(CIO) 포럼에서 그린 메모리 전략을 발표하며 30나노급 1.25V 서버용 D램을 공개할 예정이다.



삼성전자는 2009년 40나노급 DDR D램을 출시하며 저전력제품 라인을 1.35V까지 확대했고, 30나노급 DDR D램을 기반으로 1.25V까지 라인업을 확대했다.

1.25V 서버용은 1333Mbps 동작속도의 고성능 서버에서 시간당 소비전력이 3.7W에 불과해 기존제품보다 전력 소비를 15% 정도 절감했다.

40나노급 1.35V서버용과 비교하면 전기 절감효과가 60%에 달한다.

삼성전자는 2012년부터 대규모 전력을 소비하는 데이터센터 및 대용량 엔터프라이즈 시장에 신제품을 본격적으로 공급하기 위해 4GB, 8GB, 16GB RDIMM 등을 추가 개발해 고객평가가 끝나는 대로 양산할 예정이다.

삼성전자는 2012년까지 4Gb D램을 기반으로 최대 용량인 32GB RDIMM 등을 출시할 계획이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2011/09/15>